

Содержание

• XV Международная конференция „Термоэлектрики и их применения — 2016“Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2016 г.	
Коржуев М.А., Михайлова А.Б., Кретова М.А., Авилов Е.С.	
Анализ кристаллической структуры сплавов семейства $ (\text{Ge}, \text{Sn}, \text{Pb})(\text{Te}, \text{Se}) _m (\text{Bi}, \text{Sb})_2(\text{Te}, \text{Se})_3 _n$ ($m, n = 0, 1, 2, \dots$) в рамках теории плотнейших шаровых упаковок	1011
Кузнецова В.С., Зайцев В.К., Соломкин Ф.Ю., Новиков С.В.	
Анизотропия термоэдс в высших силицидах переходных металлов	1014
Бойков Ю.А., Данилов В.А.	
Отклик термоэлектрических параметров пленок $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$ на вторичную рекристаллизацию	1018
Лебедев Ю.П., Иванов А.С., Ильин А.С., Чуйко А.Г.	
Определение термоэлектрической эффективности материала по измерениям линейного ряда ветвей n - и p -типов проводимости	1021
Пошехонов Р.А., Арутюнян Г.А., Панкратов С.А., Осипков А.С., Онищенко Д.О., Леонтьев А.И.	
Разработка математической модели для оптимизации конструкции автомобильного термоэлектрического генератора с учетом влияния его гидравлического сопротивления на мощность двигателя	1023
Иванова Л.Д., Нихезина И.Ю., Гранаткина Ю.В., Дударев В.А., Кичик С.А., Мельников А.А.	
Термоэлементы из твердых растворов халькогенидов висмута и сурьмы	1028
Япринцев М.Н., Любушкин Р.А., Соклакова О.Н., Иванов О.Н.	
Особенности транспортных свойств соединения $\text{Lu}_{0.1}\text{Bi}_{1.9}\text{Te}_3$	1031
Немов С.А., Улашкевич Ю.В., Аллахаха А.А., Джадаров М.Б.	
О зонной структуре твердых растворов $\text{Sb}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ ($0 \leq x \leq 0.1$) по данным кинетических и оптических явлений	1034
Драбкин И.А., Освенский В.Б., Сорокин А.И., Панченко В.П., Нарожная О.Е.	
Контактные сопротивления в составных термоэлектрических ветвях	1038
Кузанян А.А., Кузанян А.С., Бадалян Г.Р., Петросян С.И., Варданян В.О., Гурин В.Н., Волков М.П., Пилосян С.Х.	
Тонкие пленки CsB_6 , полученные методом электронно-лучевого напыления на различных подложках	1041

Иванова Л.Д., Гранаткина Ю.В., Петрова Л.И., Нихезина И.Ю., Мальчев А.Г., Алекнов В.В., Кичик С.А., Мельников А.А.

Термоэлектрические свойства твердого раствора $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.4}\text{Se}_{0.6}$ различного гранулометрического состава 1044

Исащенко Г.Н., Самунин А.Ю., Зайцев В.К., Гуриева Е.А., Константинов П.П.

Термоэлектрические свойства твердого раствора $\text{Mg}_2\text{Ge}_{0.3}\text{Sn}_{0.7}$ p -типа проводимости 1048

Драбкин И.А., Освенский В.Б.

Оптимизация составной генераторной ветви 1052

Прокофьева Л.В., Насрединов Ф.С., Константинов П.П., Шабалдин А.А.

Оптимальный рабочий диапазон температур и оценка срока службы термоэлектрика $\text{ZnSb} : 0.1 \text{ ат\% Cu}$ 1055

Михайлин Н.Ю., Парфеньев Р.В., Черняев А.В., Шамшур Д.В., Андрианов Г.О.

Сверхпроводящие свойства $(\text{Pb}_{0.05}\text{Sn}_{0.95})\text{Te}$, легированного индием, в условиях гидростатического сжатия 1060

Демчегло В.Д., Воронин А.И., Табачкова Н.Ю., Бублик В.Т., Пономарев В.Ф.

Структура пластин твердого раствора $\text{Bi}_2\text{Se}_{0.3}\text{Te}_{2.7}$, полученных кристаллизацией в плоской полости методом Бриджмена 1064

Бурков А.Т., Новиков С.В., Танг Х., Ян Я.

Термоэлектрические свойства лент $\text{Bi}_{0.5}\text{Sb}_{1.5}\text{Te}_3$, полученных методом спиннингования расплава 1068

• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Боднарь И.В., Тхан Чан Бинь

Монокристаллы $\text{Mn}_{0.1}\text{Ag}_{0.9}\text{In}_{4.7}\text{S}_{7.6}$: кристаллическая структура, ширина запрещенной зоны и тепловое расширение . 1071

Шуман В.Б., Астров Ю.А., Лодыгин А.Н., Порцель Л.М.

Высокотемпературная диффузия магния в бездислокационном кремнии 1075

• Электронные свойства полупроводников

Соболев В.В., Перевоцников Д.А.

Сложная структура оптических переходов с остовных d -уровней кристаллов InAs и InSb 1078

Чупыра С.М., Грушка О.Г., Биличук С.В.

Примесные уровни в кристаллах $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$ 1085

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Лебедев А.А., Бер Б.Я., Оганесян Г.А., Белов С.В., Лебедев С.П., Никитина И.П., Середова Н.В., Шахов Л.В., Козловский В.В.

Воздействие протонного облучения с энергией 8 МэВ на гетероэпитаксиальные слои n -3C-SiC 1088

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Секербаев К.С., Таурбаев Е.Т., Ефимова А.И., Тимошенко В.Ю., Таурбаев Т.И.

Влияние свободных носителей заряда на двулучепреломление и дихроизм в слоях анизотропного пористого кремния 1091

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Керими М.Б.

Распространение потока носителей заряда в тонком слое плоскопараллельной твердотельной структуры с учетом рассеяния на границах слоя 1096

Александров О.В.

Влияние ловушек в диоксиде кремния на пробой МОП-структур 1105

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Гаврилин И.М., Громов Д.Г., Дронов А.А., Дубков С.В., Волков Р.Л., Трифонов А.Ю., Боргардт Н.И., Гаврилов С.А.

Влияние температуры электролита на процесс катодного осаждения нитевидныхnanoструктур Ge из водных растворов на частицах In и Sn 1110

• Углеродные системы

Давыдов В.Ю., Усачёв Д.Ю., Лебедев С.П., Смирнов А.Н., Левицкий В.С., Елисеев И.А., Алексеев П.А., Дунаевский М.С., Вилков О.Ю., Рыбкин А.Г., Лебедев А.А.

Исследование кристаллической и электронной структуры графеновых пленок, выращенных на 6H-SiC (0001) 1116

• Физика полупроводниковых приборов

Мнацаканов Т.Т., Тандоев А.Г., Левинштейн М.Е., Юрков С.Н., Palmour J.W.

Вольт-амперные характеристики диодов Шоттки при больших плотностях тока в условиях инжекции неосновных носителей 1125

• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Середин П.В., Леньшин А.С., Худяков Ю.Ю., Арсентьев И.Н., Калюжный Н.А., Минтаиров С.А., Николаев Д.Н., Prutskij Tatiana

Экспериментальные исследования влияния эффектов атомного упорядочения в эпитаксиальных твердых растворах $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$ на их структурные и морфологические свойства 1131

Лебедев М.В., Львова Т.В., Павлов С.И., Седова И.В.

Влияние растворителя сульфида аммония на пассивацию поверхности GaSb(100) 1138

Сокура Л.А., Пархоменко Я.А., Моисеев К.Д., Неведомский В.Н., Берт Н.А.

Квантовые точки InSb, полученные методом жидкокристаллической эпитаксии на подложке InGaAsSb/GaSb 1146